МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Харківський національний університет радіоелектроніки

ЗАТВЕРДЖЕНО
Вченою радою ХНУРЕ протокол № 5
від "20" 04 2018 року

ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор ХНУРЕ
В.В. Семенець
" " 20 року

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

підготовки ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

Прийом 2018 року (березень)

Кваліфікація доктор філософії з прикладної фізики та наноматеріалів

Строк навчання 4 роки

на основі ступеня магістра

Підготовка третього (освітньо-наукового) рівня доктора філософії з галузі знань 10-Природничі науки спеціальність 105-Прикладна фізика та наноматеріали

| Навчальні тижні | | |

Додаток 1

Навчальний план підготовки докторів філософіїї спеціальності 105 Прикладна фізика та наноматеріали

Прийом 2018 р

Термін навчання - 4 роки

| № п/п | Найменування дисципліни | Семестровий контроль | | | | Кредитів ЄКТС | Години | | | | Консультації | Самостійна робота | Розподіл навчального часу по курсам та семестрам | | | |

2. ОСВІТНЯ СКЛАДОВА. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ

№ п/п	Найменування дисципліни	Семестровий контроль: Екзамени	Заліки	РГЗ та КР	Курсова проекти	Кредитів ЄКТС	Години: Всього	Аудиторні години: Лекції	Практичні	Лабораторні	Консультації	Самостійна робота	Розподіл навчального часу по курсам та семестрам: 1 курс, 1 семестр (15 тиж.), Аудиторні години: ЛК	ПЗ	ЛБ	Кон.	1 курс, 2 семестр (16 тиж.), Аудиторні години: ЛК	ПЗ	ЛБ	Кон.	2 курс, 3 семестр, Аудиторні години: ЛК	ПЗ	ЛБ	Кон.	2 курс, 4 семестр, Аудиторні години: ЛК	ПЗ	ЛБ	Кон.	3 курс, 5 семестр, Аудиторні години: ЛК	ПЗ	ЛБ	Кон.	3 курс, 6 семестр, Аудиторні години: ЛК	ПЗ	ЛБ	Кон.	4 курс, 7 семестр, Аудиторні години: ЛК	ПЗ	ЛБ	Кон.	4 курс, 8 семестр, Аудиторні години: ЛК	ПЗ	ЛБ	Кон.	Кафедра
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
	Дисципліни професійної та практичної підготовки за спеціалізацією (вибіркові)																																												
8.1	Нанотехнології в оптоелектроніці	2				10	300	60	40		14	186	30	20		8	30	20		6																									МЕЕПП, Пащенко
8.2	Комп'ютерні методи нанофотоніки	2				10	300	60	40		14	186	30	20		8	30	20		6																									ФП, Одаренко
8.3	Теорія і техніка радіофізичних систем інтроскопії природних середовищ та об'єктів	2				10	300	60	40		14	186	30	20		8	30	20		6																									МРЕС, Карташов
8.4	Спеціальні розділи математичної фізики та комп'ютерне моделювання процесів і систем	2				10	300	60	40		14	186	30	20		8	30	20		6																									ПЕЕА, Панченко, Хорошайло
	Всього:					10	300	60	40	0	14	186	30	20	0	8	30	20	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Всього за термін навчання:					10	300	60	40	0	14	186	30	20	0	8	30	20	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Всього вибіркові компоненти:					10	300	60	40	0	14	186	30	20	0	8	30	20	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

3 НАУКОВА СКЛАДОВА

11	Проведення наукового дослідження	2 роки					0					0																																		
12	Обробка та оформлення результатів дослідження	1 рік					0					0																																		
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	Всього кредитів ECTS за семестр	21,0	19,0								Всього:
	Кількість аудиторних годин на тиждень	16,8	12,7								40,0
Кількість	Іспитів комбінованих										
	Заліків	4	4								0
	Курсових робіт										11
	Атестацій										0
										захист дисертаційної роботи	

Завідувач кафедри
Ю.Л. Мачехін

Завідувач кафедри
В.М. Карташов

Завідувач кафедри
О.Ю. Панченко

Проректор з НМР І.В. Рубан

Керівник ОМЦ І.В. Магдаліна

Керівник проектної групи Ю.О. Гордієнко

Завідувач кафедри І.М. Бондаренко

Завідувач відділу аспірантури та докторантури В.П. Манаков

Начальник навчального відділу А.В. Міхнова